## Micron 宣佈推出 30 納米 DDR3L-RS 產品 以支持新一代 Intel Ultrabook(TM)和超薄 計算設備

## Micron 是在待機低功耗 DDR3 這一新類型產品上 獲得 Intel 驗證的第一家供應商

愛達荷州博伊西,2012年9月20日(GLOBE NEWSWIRE)--世界領先的先進半導體解決方案供應商之一 Micron Technology, Inc. (納斯達克股票代碼: MU),今日宣佈推出用於超薄計算設備和平板電腦的高容量30納米(nm)低功耗 DDR3L-RS SDRAM。2Gb和4Gb低功耗解決方案在待機狀態下提供更長的電池使用壽命的同時也保持了個人電腦 DRAM 的高性能和成本效益。

"Micron 已成為 DDR3L-RS 開發和商業化方面的領導者之一,推出 30 納米產品證實了這一點",IHS iSuppli 公司 DRAM 和記憶體首席高級分析師 Mike Howard說到。"對於能源預算嚴緊同時又需要以有競爭力的價格獲得高性能的用戶而言,DDR3L-RS 是非常優秀的選擇。我們預計大量下一代超薄平臺將利用 DDR3L-RS的優異性能"。

這些設備以前被稱為"DDR3Lm",通過減少自刷新功率(IDD6)從而全面改善系統能耗,使 Micron 能夠向晶片組供應商、授權開發商和電子產品製造商提供擁有與標準 DRAM 同類性能、品質和可靠性的一流低功耗記憶體。DDR3L-RS 能夠滿足當今不斷擴大的超薄計算和平板電腦市場的需要,為增強諸如 Intel Ultrabook設備的產品特性和功能鋪平了道路。

"我們的用戶對這新一代 DRAM 的回饋資訊極其積極",Micron DRAM 行銷副總裁 Robert Feurle 說到。"我們很高興能成為 DRAM 解決方案的領先供應商,這使推出的超薄筆記本電腦和平板電腦更薄、運行更快、一次充電後運行時間更久。"

Micron 已實現成為第一家獲得 Intel 認證的 DDR3L-RS 產品供應商的目標,這已在 Inter 網站上得到證實。

"Micron 是在使用 DDR3L-RS 的 Ivy Bridge 平臺上得到驗證的第一家 DRAM 供應商,為低功耗個人電腦 DRAM 設立了行業標準",Inter 記憶體支援高級經理 Geof Findley 說到。

除了 2Gb 和 4Gb 設備外, Micron 已開始 8Gb x 32 DDR3L-RS 的樣品開發並即將推出 8Gb x 16 DDR3L-RS 樣品;預計將於 2012年 12 月投產。這些產品通過減少主板空間和增加密度從而為系統設計提供額外的靈活性。預計在 2013 年初推出的 DDR4-RS 將能夠提供額外的節能和節省空間功能。

通過這次產品發佈,Micron 將憑藉其廣泛的 DRAM、NAND、NOR 和 SSD 解決方案組合充分支援超薄應用。欲瞭解更多資訊,請訪問 www.micron.com。

Micron Technology, Inc. 徽標位於 http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950

聯繫方式: Mary Ellen Ynes maryellen.ynes@zenogroup.com 650-801-7954